

# Эласто-дипольный механизм формирования и коллапса резонансов Фано при прохождении поперечных фононов через слоистые магнитные гетероструктуры

О. С. Сухорукова<sup>+</sup>, А. С. Тарасенко<sup>+</sup>, С. В. Тарасенко<sup>+1)</sup>, В. Г. Шавров\*

<sup>+</sup>Донецкий физико-технический институт им. А. А. Галкина, 283048 Донецк, Украина

\*Институт радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН, 125009 Москва, Россия

Поступила в редакцию 19 августа 2020 г.

После переработки 7 сентября 2020 г.

Принята к публикации 7 сентября 2020 г.

При резонансном прохождении сдвиговой плоской упругой волной акустически сплошной гетероструктуры из магнитных и немагнитных слоев в симметричном немагнитном окружении возбуждение распространяющихся как безобменных, так и обменных спиновых волн может приводить к формированию эласто-дипольного аналога не только резонанса Фано, но и сопутствующих динамических эффектов, включая коллапс резонанса Фано и возникновение связанных магнитных состояний в континууме поперечных фононов.

DOI: 10.31857/S1234567820190052

Одним из магистральных направлений в современной физике композитных упругих сред является поиск акустических аналогов резонансных поляритонных эффектов, характерных для динамики электромагнитных метаматериалов [1, 2]. При этом в последние годы значительное внимание исследователей привлекло изучение как поляритонного механизма формирования самого резонанса Фано, так и связанных с ним динамических эффектов (в частности, таких как коллапс резонансов Фано, темные моды, суперрезонанс, сверхизлучение) [3, 4]. Естественно, что это нашло свое отражение и в развитии современной физики упругих метаматериалов, а интенсификация исследовательских работ в области гибридации спинтроники и стрейнтроники привела к тому, что особое внимание стало уделяться изучению возможностей использования магнитных гетероструктур (в том числе и слоистых) как новой элементной базы для создания эффективно управляемых акустических метаматериалов [5, 6]. В частности, значительный исследовательский интерес вызывает поиск магнитоакустических аналогов указанных выше динамических поляритонных эффектов. Как пример, можно указать на появившуюся в последние годы серию статей [7–10], в которых для касательно немагнитного ферромагнитного (ФМ) слоя, акустически жестко связанного с неограниченным упругоизотропным немагнитным диэлектриком, теорети-

чески рассматривалась возможность существования магнитоупругого (МУ) варианта резонанса Фано в условиях наклонного падения на слой плоской сдвиговой объемной упругой волны (акустический аналог геометрии Фогта). Однако с точки зрения вопросов, обсуждаемых в нашей статье, указанный цикл работ основан на существенном ограничении: выбранная авторами [7–10] для анализа теоретическая модель не учитывала вклад в МУ динамику магнитного слоя распространяющихся ни магнитоэластических, ни обменных спиновых волн.

В связи с этим в данной работе для случая тунелирования плоской сдвиговой объемной упругой волны через акустически сплошные гетероструктуры с участием сверхпроводящих, а также магнитных и немагнитных диэлектрических слоев изучен магнитный вклад в эласто-дипольный механизм формирования как резонанса Фано, так и связанных с ним динамических эффектов, включая коллапс резонанса Фано, формирование связанных состояний в континууме, сверхизлучение.

Пусть имеются два полупространства, занятые идентичным упруго изотропным диэлектриком (соответствующие величины будем обозначать знаком тильды), плотность энергии которого имеет вид ( $\tilde{\lambda}, \tilde{\mu}$  – коэффициенты Ламэ,  $u_{ik}$  – тензор упругих деформаций) [11]:

$$F = \frac{\tilde{\lambda}}{2} \tilde{u}_{ii}^2 + \tilde{\mu} \tilde{u}_{ik}^2, \quad (1)$$

<sup>1)</sup>e-mail: s.v.tarasenko@mail.ru

а на границе между эти полупространствами расположен слой толщиной  $2d$  и вектором нормали к поверхности  $\mathbf{q} \parallel OY$  одноосного гиротропного магнетика, легкая магнитная ось которого  $OZ$  коллинеарна нормали к плоскости падения  $\mathbf{a}$ . Без учета неоднородного обменного взаимодействия упругая динамика подобной магнитной среды с плотностью  $\rho$  может быть описана следующей системой динамических уравнений

$$\rho \frac{\partial^2 u_i}{\partial t^2} = \frac{\partial \sigma_{ik}}{\partial x_k}; \quad \text{div } \mathbf{B} = 0, \quad \text{rot } \mathbf{H} = 0, \quad (2)$$

где  $\bar{\sigma}$  – тензор упругих напряжений,  $\mathbf{B}$  – вектор магнитной индукции,  $\mathbf{u}$  – вектор упругих смещений,  $\mathbf{H}$  – вектор магнитного поля. Пусть у распространяющейся в магнетике акустической волне вектор упругих смещений  $\mathbf{u} \parallel OZ$ , а волновой вектор  $\mathbf{k} \in XY$  (акустический аналог геометрии Фогта). В результате уже для модели легкоосного (ось  $OZ$ ) ФМ, обладающего изотропным не только упругим ( $\lambda, \mu$  – коэффициенты Ламэ), но также МУ и магнитострикционным взаимодействиями материальные соотношения согласно [12, 13] могут быть представлены в виде:

$$\begin{cases} \sigma_{zx} = \bar{c}_{55} \frac{\partial u_z}{\partial x} + i\bar{c}_{54} \frac{\partial u_z}{\partial y} + \beta_{15} H_x - i\beta_* H_y, \\ \sigma_{zy} = \bar{c}_{44} \frac{\partial u_z}{\partial y} - i\bar{c}_{45} \frac{\partial u_z}{\partial x} + \beta_{15} H_y + i\beta_* H_x, \end{cases} \quad (3)$$

$$\begin{cases} B_x = \mu_{\perp} H_x - i\mu_* H_y - 4\pi\beta_{15} \frac{\partial u_z}{\partial x} + 4\pi i\beta_* \frac{\partial u_z}{\partial y}, \\ B_y = \mu_{\perp} H_y + i\mu_* H_x - 4\pi\beta_{15} \frac{\partial u_z}{\partial y} - 4\pi i\beta_* \frac{\partial u_z}{\partial x}, \end{cases}$$

где  $\mu_{\perp}$  и  $\mu_*$  – соответственно диагональная и недиагональные компоненты тензора магнитной проницаемости,  $c_{44} = c_{55} = \mu c_{\perp}$ ,  $c_{45} = c_{54} = \mu c_*$  и  $\beta_{15}$ ,  $\beta_*$  – соответственно динамические упругие и магнитоупругие модули, рассматриваемой ФМ среды. Таким образом в рамках пьезомагнитного подхода среда со структурой уравнений связи подобной (3) можно рассматривать как обладающую не только “нормальным” [14], но и динамическим [15] пьезомагнитным взаимодействием. Будем полагать, что на границе раздела магнитной ( $y < 0$ ) и немагнитной ( $y > 0$ ) сред с нормалью вдоль  $\mathbf{q}$  выполнена следующая система граничных условий

$$\begin{aligned} \sigma_{zy} = \tilde{\sigma}_{zy}, \quad u_z = \tilde{u}_z, \quad B_y = \mp \tilde{\mu}_{\perp} h \varphi, \\ y = \pm d, \quad \tilde{\varphi}(y \rightarrow \pm \infty) \rightarrow 0, \end{aligned} \quad (4)$$

где  $\varphi(\tilde{\varphi})$  – магнитоэлектростатический потенциал магнитной (немагнитной) среды. Согласно [16, 17] в частном случае  $\tilde{\mu}_{\perp} = 0$  (4) отвечает акустически бесконечно

тонкому слою идеально сверхпроводящего металла на границе типа жесткой склейки между магнитной и немагнитной средой. Пусть из немагнитной упругоизотропной среды (1) на поверхность рассматриваемого магнитного слоя среды (2)–(3) падает плоская сдвиговая объемная упругая волна с  $\mathbf{u} \parallel \mathbf{a}$ , единичной амплитудой и заданными значениями частоты  $\omega$  и угла падения. В результате в верхнем и нижнем полупространствах, занятых средой (1), пространственная структура поля упругих смещений в такой волне может быть соответственно представлена в виде ( $h$  – продольное волновое число)

$$\begin{aligned} \tilde{u}_z(y > d) = \\ = \left[ \exp(-i\tilde{k}_{SH}y) + V_{SH} \exp(i\tilde{k}_{SH}y) \right] \exp(i\psi_x), \\ \tilde{k}_{SH}^2 \equiv \omega^2 / \tilde{s}_t^2 - h^2, \\ \tilde{u}_z(y < -d) = W_{SH} \exp(-i\tilde{k}_{SH}y) \exp(i\psi_x), \\ \psi_x \equiv hx - \omega t, \end{aligned} \quad (5)$$

где  $V_{SH}(W_{SH})$  – амплитудные коэффициенты отражения и прохождения для слоя в случае сдвиговой упругой волны, обладающей скоростью  $\tilde{s}_t$  в среде (1), ( $V_{SH}^2 + W_{SH}^2 = 1$ ). Пространственную структуру полей  $u_z$  и  $\varphi$  в слое ФМ (2)–(3) можно представить как

$$\begin{aligned} u_z = [A \text{ch}(\eta_{SH}y) + B \text{sh}(\eta_{SH}y)] \exp(i\psi_x), \\ \varphi = [C \text{ch}(hy) + D \text{sh}(hy)] \exp(i\psi_x) - \frac{4\pi\beta_{15}}{\mu_{\perp}} u_z, \end{aligned} \quad (6)$$

где  $A, B, C, D$  – подлежащие определению амплитуды,  $\eta_{SH}^2 = h^2 - \omega^2 / (s_t^2 c'_{\perp}) > 0$ ,  $c'_{\perp} \equiv c_{\perp} + 4\pi\beta_{15}^2 / (\mu\mu_{\perp})$ . По аналогии с методикой расчета из [18, 19] можно с помощью магнитоэлектростатических граничных условий (4) исключить из дальнейшего рассмотрения две из четырех амплитуд парциальных волн. Если  $C, D$ , то

$$\begin{pmatrix} C \\ D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \Phi_{CA} & \Phi_{CB} \\ \Phi_{DA} & \Phi_{DB} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}. \quad (7)$$

При этом для  $\eta_{SH}^2 < 0$  в (6)  $\Phi_{CA} = \Phi_{DA} = 0$  в случае  $\text{ch}(\eta_{SH}d) = 0$ , а если  $\text{sh}(\eta_{SH}d) = 0$ , то в (7)  $\Phi_{CB} = \Phi_{DB} = 0$ . Кроме того, если в (7)  $C = D = 0$ , то для  $A, B \neq 0$  необходимо выполнение условия

$$\Delta = 0, \quad \Delta \equiv \mu_{\perp}^2 - \mu_*^2 + \tilde{\mu}_{\perp}^2 + 2\tilde{\mu}_{\perp}\mu_{\perp} \text{cth}(2hd), \quad (8)$$

что с учетом (2)–(4) отвечает спектру поверхностных магнитоэлектростатических волн (ПМСВ) гиротропного слоя в геометрии Фогта при симметричном диэлектрическом (для  $\tilde{\mu}_{\perp} \neq 0$ ) или идеальном сверх-

проводящем (для  $\tilde{\mu}_\perp = 0$ ) окружении. В результате для сдвиговой упругой волны пространственную структуру компонента вектора упругих смещений  $\mathbf{u} \parallel \mathbf{a}$  и тензора упругих напряжений  $\mathbf{q} \bar{\sigma} \mathbf{a}$  в ФМ среде (2)–(3), (6), (7) можно представить как

$$\begin{pmatrix} \mathbf{u} \mathbf{a} \\ \mathbf{q} \bar{\sigma} \mathbf{a} \end{pmatrix}_{y=d} = \begin{pmatrix} Q_{11} & Q_{12} \\ Q_{21} & Q_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}, \quad (9)$$

$$Q_{11} = c_\eta, \quad Q_{21} = \bar{c}'_\perp \eta_{SH} s_\eta + \bar{c}_* \sigma h c_\eta +$$

$$+ \Phi_{CA} h (-\beta_{15} s_h + \beta_* c_h) + \Phi_{DA} h (-\beta_{15} c_h + \beta_* s_h), \quad (10)$$

$$Q_{12} = s_\eta, \quad Q_{22} = \bar{c}'_\perp \eta_{SH} c_\eta + c_* \sigma h s_\eta +$$

$$+ \Phi_{CB} h (-\beta_{15} s_h + \beta_* c_h) + \Phi_{DB} h (-\beta_{15} c_h + \beta_* s_h),$$

где  $\bar{c}_* \equiv c_* - 4\pi\beta_{15}\beta_*/\mu_\perp$ ,  $c_\eta \equiv \text{ch}(\eta_{SH}d)$ ,  $s_\eta \equiv \text{sh}(\eta_{SH}d)$ ,  $c_h \equiv \text{ch}(hd)$ ,  $s_h \equiv \text{sh}(hd)$ , а значит для рассматриваемого ФМ слоя толщиной имеет место следующая матрица перехода

$$\begin{pmatrix} \mathbf{u} \mathbf{a} \\ \mathbf{q} \bar{\sigma} \mathbf{a} \end{pmatrix}_{y=d} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{u} \mathbf{a} \\ \mathbf{q} \bar{\sigma} \mathbf{a} \end{pmatrix},$$

$$\bar{T} = \bar{Q}(d)\bar{Q}^{-1}(d \rightarrow -d). \quad (11)$$

Так как для обсуждаемой слоистой магнитной гетероструктуры в (9)–(11)  $T_{11} \neq T_{22}$ , то для падающей извне на поверхность ФМ слоя сдвиговой плоской упругой волны  $SH$ -типа ( $\mathbf{k} \in XY, \mathbf{q} \parallel OY, \mathbf{m}_0 \parallel \mathbf{u} \parallel OZ$ ) структуру амплитудного коэффициента прохождения  $W_{SH}(\omega, h)$ , можно представить как

$$W_{SH} = \frac{i2\tilde{Z}_{SH}}{i\tilde{Z}_{SH}(T_{11} + T_{22}) - T_{21} + \tilde{Z}_{SH}^2 T_{12}}. \quad (12)$$

В этом случае, как показывает расчет, становится принципиально возможным формирование акустического аналога асимметричного резонанса (резонанса Фано). В частности, условию полной акустической непроницаемости рассматриваемого магнитного слоя для сдвиговой объемной волны ( $W_{SH} = 0$ ) отвечают сочетания частоты и продольного волнового числа удовлетворяющие  $Q_{11}Q_{22} = Q_{12}Q_{21}$ . Акустический аналог эффекта коллапса резонанса Фано реализуются при таких сочетаниях  $\omega$  и  $h$ , для которых одновременно обращаются в нуль и числитель  $W_{SH}$  (в частности, возможно если при  $\eta_{SH}^2 < 0$  одновременно с (8) выполнено также условие  $\text{sh}(2\eta_{SH}d) = 0$ ). Согласно [4, 20] такие точки на плоскости внешних параметров  $\omega$  и  $h$  называют также связанными состояниями в континууме (ССК), а в (12) при этом  $0 < |W_{SH}| < 1$ . Как показывает расчет, условия

$\text{sh}(2\eta_{SH}d) = \Delta = 0$  определяют с учетом магнитодипольного и МУ взаимодействия точки вырождения спектра сдвиговых объемных МУ волн, распространяющихся вдоль слоя ФМ среды (2)–(3), обе поверхности которого жестко закреплены, т.е. в (4)  $\tilde{u}_z = 0$  [11].

Если же соотношение между частотой и углом падения сдвиговой упругой волны в среде (1) таково, что при  $\eta_{SH}^2 < 0$  в (8)–(9)  $Q_{11} = 0$  или  $Q_{12} = 0$ , то (12) принимает вид

$$W_{SH}(\text{sh}(2\eta_{SH}d) = 0) \approx \frac{\Delta}{\Delta + i\Gamma};$$

$$\Gamma = \begin{cases} \Gamma_c, & \text{ch}(\eta_{SH}d) = 0, \\ \Gamma_s, & \text{sh}(\eta_{SH}d) = 0, \end{cases} \quad (13)$$

где  $\Gamma$  ( $\text{Im}\{\Gamma\} = 0$ ) характеризует радиационное затухание ПМСВ с законом дисперсии  $\Delta$  (8) за счет излучения сдвиговой объемной упругой волны в немагнитную среду (1), окружающую ФМ слой (9)–(11). Таким образом, в данном частном случае возможно  $W_{SH} = 0$  при  $W_{SH}^{-1} \neq 0$ . Подчеркнем, что для рассматриваемой магнитной слоистой гетероструктуры отмеченные выше эффекты, связанные с формированием и коллапсом резонансов Фано (формированием ССК) для падающей извне плоской сдвиговой объемной волны, в принципе сохраняются и в случае, когда на акустически сплошной границе раздела немагнитной и ФМ сред имеется бесконечно тонкое покрытие из идеального сверхпроводника (в (4)  $\tilde{\mu} = 0$ ).

Ряд дополнительных резонансных аномалий в изучаемой магнитоакустической конфигурации возникает и в случае, когда ФМ слой с двухсторонним покрытием из бесконечно тонкого идеального сверхпроводника является элементарным периодом для одномерного акустически сплошного магнитного фоновонного кристалла (МФК). Будем полагать, что такой конечный МФК, состоящий из  $N$  элементарных периодов с толщиной  $2d$  помещен в неограниченную упругоизотропную среду (1), в целом указанная магнитная гетероструктура является акустически сплошной [11]. Соответствующая система граничных условий и матрица перехода в этом случае с учетом (9)–(11) может быть представлена в виде [19]

$$\sigma_{zy} = \tilde{\sigma}_{zy}, \quad u_z = \tilde{u}, \quad B_y = 0, \quad y = \pm Nd, \quad (14)$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{u} \mathbf{a} \\ \mathbf{q} \bar{\sigma} \mathbf{a} \end{pmatrix}_{y=Nd} = \begin{pmatrix} T_{11} & T_{12} \\ T_{21} & T_{22} \end{pmatrix}^N \begin{pmatrix} \mathbf{u} \mathbf{a} \\ \mathbf{q} \bar{\sigma} \mathbf{a} \end{pmatrix}_{y=-Nd}.$$

Таким образом, в рассматриваемой сверхструктуре с периодом  $2d$  и выбранной магнитоакустической

конфигурации роль квазиблоховского волнового вектора выполняет  $k_{SH}(k_{SH}^2 \equiv -\eta_{SH}^2)$ . В результате если  $k_{SH}^2 > 0$ , с учетом (9)–(11) для рассматриваемого конечного 1D МФК (см. также [3, 18, 21]):

$$W_N(\omega, h) = \frac{W_{SH}}{U_{N-1} - W_{SH}U_{N-2}};$$

$$U_{N-1} \equiv \frac{\sin(2Nk_{SH}d)}{\sin(2k_{SH}d)}; \quad (15)$$

$$\cos(2k_{SH}d) = \frac{1}{2}(T_{11} + T_{22}).$$

Из (15) следует, что эффекты отражения и полного прохождения сдвиговой упругой волны через подобную рассматриваемую слоистую структуру существенно зависят от коэффициентов отражения  $V_{SH}(\omega, h)$  и прохождения  $W_{SH}(\omega, h)$  волны  $SH$ -типа через элементарный период 1D МФК с матрицей перехода  $\bar{T}(D)$  (9)–(11). Это, в частности, означает, что найденные выше для ФМ слоя в симметричном окружении эффекты формирования дискретного магнотонного состояния на фоне сплошного спектра, полного отражения волны с  $\alpha = p, s$  от ФМ слоя (9)–(11) останутся в силе и для  $N$ -слойного 1D МФК (14), (15), независимо от числа элементарных периодов  $N$ . Вместе с тем возможны и дополнительные эффекты. В частности, расчет показывает, что если толщина элементарного периода рассматриваемого фотонного кристалла (магнитного слоя) такова, что  $2k_{SH}d = \pi$ , то с учетом (13) получаем для сдвиговой упругой волны магнитоакустический аналог резонансного 1D брэгговского фотонного кристалла с участием экситонных поляритонов [3, 21], поскольку, если  $\eta_{SH}^2 < 0$ , то

$$W_N(\text{sh}(2\eta_{SH}d) = 0) \cong \frac{\Delta(\tilde{\mu} = 0)}{\Delta(\tilde{\mu} = 0) + iN\Gamma(\tilde{\mu} = 0)}, \quad (16)$$

а значит, согласно (12), (13), (16), радиационное затухание ПМСВ слоя, входящего в состав конечного ФК из  $N$  слоев в немагнитном окружении, может быть в  $N$  раз больше, чем в случае изолированного ФМ слоя с двухсторонней металлизацией. Таким образом, если воспользоваться сходством с динамикой экситонных поляритонов в резонансных брэгговских гетероструктурах с периодически расположенными квантовыми ямами [3, 21], то на основании (9)–(11), (14)–(16) можно утверждать, что для ПМСВ в ФМ слое с двухсторонним бесконечно тонким покрытием идеальным сверхпроводником ( $\Delta(\tilde{\mu}_\perp = 0) \equiv \Delta_0$ ) становится возможным также и магнитоакустический аналог эффекта сверхизлучения. В частности, если  $k_{SH} = k'_{SH} + ik''_{SH}$  и одновременно  $2k'_{SH}d = \pi$ , то

при  $2k''_{SH}Nd \ll 1$  в спектре сдвиговых магнитоупругих волн обсуждаемого 1D МФК с  $N$  ультратонкими металлизированными ФМ слоями имеет место одновременное наличие  $N - 1$  нерадиационных (“темных” [3]) эласто-дипольных мод ( $|W_N| = 0$ ) и одной сверхизлучающей (“светлой” [3]) моды, спектр которой отвечает в (16) полюсу  $W_N$ . Согласно (16) ее время жизни в такой магнитной гетероструктуре в  $N$  раз меньше, чем у эласто-дипольной волны с  $\mathbf{u} \parallel \mathbf{a}$  в уединенном в среде (1) ФМ слое с двухсторонней металлизацией (13).

Вместе с тем анализ показывает, что ни магнитная ( $\mu_* \neq 0$ ), ни акустическая ( $c_* \neq 0$ ) гиротропия магнитной среды (в рассмотренном примере ЛО ФМ) не являются необходимыми условиями для формирования выше перечисленных резонансных эффектов. В частности, из (1)–(16) следует, что все выше перечисленные для сдвиговой волны  $SH$ -типа эффекты, относящиеся к формированию и коллапсу резонанса Фано, а также эффекту акустического сверхизлучения, остаются в силе, даже если для коэффициентов в уравнениях связи (3) магнитной среды выполнены условия

$$\beta_{15} = c_* = \mu_* = 0, \quad (17)$$

вследствие чего в (7)  $\Phi_{CA} = \Phi_{DB} = 0$ . Расчет показывает, что для слоя негиротропной среды (2)–(3), (17), в симметричном немагнитном окружении (1) и при выполнении граничных условий (4) спектр распространяющихся в плоскости  $XY$  вдоль рассматриваемого магнитного слоя вытекающих (или собственных) сдвиговых эластодипольных волн с  $\mathbf{u} \parallel OZ$  факторизуется (независимое распространение симметричных и антисимметричных относительно срединной плоскости магнитного слоя упругих волн  $SH$ -типа). Если в случае (17) обозначить в (9)  $\bar{Q} \equiv \bar{Q}^0$ , то, используя (9)–(11), структуру амплитудных коэффициентов прохождения и отражения теперь можно представить как

$$W_{SH} = \frac{P_+ - P_-}{2}; \quad V_{SH} = \frac{P_+ + P_-}{2};$$

$$P_- \equiv \frac{Q_{22}^0 + i\tilde{Z}_{SH}Q_{12}^0}{Q_{22}^0 - i\tilde{Z}_{SH}Q_{12}^0}; \quad P_+ \equiv \frac{Q_{21}^0 + i\tilde{Z}_{SH}Q_{11}^0}{Q_{21}^0 - i\tilde{Z}_{SH}Q_{11}^0}. \quad (18)$$

Таким образом, поскольку для (12), (18) имеют место соотношения

$$Q_{22}^0Q_{11}^0 = Q_{12}^0Q_{21}^0, \quad (W_{SH} = 0),$$

$$Q_{22}^0Q_{21}^0 + \tilde{Z}_{SH}^2Q_{11}^0Q_{12}^0 = 0, \quad (|W_{SH}| = 1), \quad (19)$$

$$(Q_{22}^0 - i\tilde{Z}_{SH}Q_{12}^0)(Q_{21}^0 - i\tilde{Z}_{SH}Q_{11}^0) = 0, \quad (W_{SH}^{-1} = 0),$$

то при

$$Q_{21}^0 = Q_{11}^0 = 0 \quad \text{или} \quad Q_{22}^0 = Q_{12}^0 = 0 \quad (20)$$

формально все три равенства в (19) выполнены одновременно. Однако поскольку в этом случае совпадают полюс и ноль коэффициента прохождения  $W_{SH}$  (так же, как полюс и ноль коэффициента отражения  $V_{SH}$ ), то из (12), (18) следует что, при выполнении (20)  $0 < |W_{SH}| < 1$ , и это, по аналогии с [22], отвечает коллапсу акустического резонанса Фано для рассматриваемой слоистой акустически сплошной магнитной гетероструктуры. Для соответствующей (17) структуре уравнений связи (3) это возможно в случае  $\eta_{SH}^2 < 0$  и для таких сочетаний  $\omega$  и  $h$  одновременно отвечают  $\text{ch}(\eta_{SH}d) = 0$ ;  $\Delta_s \equiv \mu_{\perp} \text{ch}(hd) + \tilde{\mu} \text{sh}(hd) = 0$  или  $\Delta_c \equiv \mu_{\perp} \text{sh}(hd) + \tilde{\mu} \text{ch}(hd) = 0$ ,  $\text{sh}(\eta_{SH}d) = 0$ . Эти точки на плоскости внешних параметров  $\omega$  и  $h$  согласно [4, 21, 22] могут рассматриваться как ССК (в данном случае ПМСВ негиротропно АФМ слоя в континууме сдвиговых упругих волн немагнитной среды, окружающей магнетик). Так как в случае (17) в (12), (18) – одновременно обращаются в ноль и действительная, и мнимая часть  $W$ , то сочетания  $\omega$  и  $h$ , одновременно отвечающие ССК (20) могут, следуя аналогии с динамикой экситонных поляритонов изложенной в [3, 21, 22] рассматриваться и как темные эласто-дипольные моды с  $\mathbf{u} \parallel \mathbf{a}$ . Если

$$\begin{aligned} Q_{21}^0 Q_{11}^0 = 0, \quad |Q_{12}^0| + |Q_{22}^0| \neq 0 \\ \text{или} \\ Q_{12}^0 Q_{22}^0 = 0, \quad |Q_{11}^0| + |Q_{21}^0| \neq 0, \end{aligned} \quad (21)$$

то уже при выполнении (3), (17) структурно сохраняются как соотношения (13), (16), так и связанные с ними отмеченные выше динамические магнитоакустические эффекты.

Как пример среды с уравнениями связи (3), (17) можно рассмотреть двухподрешеточную модель ( $|\mathbf{M}_1| = |\mathbf{M}_2| = M_0$ ,  $M_0$  – намагниченность насыщения подрешеток  $\mathbf{M}_{1,2}$ ) обменно-коллинеарного, центросимметричного, легкоосного ( $OZ$ ) АФМ, плотность термодинамического потенциала которого в терминах векторов ферро- ( $\mathbf{m}$ ) и антиферромагнетизма ( $\mathbf{l}$ ) можно представить как [23]:

$$\begin{aligned} F_{AF} = M_0^2 \left( \frac{\delta}{2} \mathbf{m}^2 - \frac{b}{2} l_z^2 + \gamma l_i l_k u_{ik} - 2\mathbf{m}\mathbf{h} \right) + \frac{\lambda}{2} u_{ii}^2 + \mu u_{ik}^2, \\ \mathbf{m} = \frac{\mathbf{M}_1 + \mathbf{M}_2}{2M_0}, \quad \mathbf{l} = \frac{\mathbf{M}_1 - \mathbf{M}_2}{2M_0}, \end{aligned} \quad (22)$$

где  $\delta$ ,  $b$  – соответственно константы однородного обмена и одноосной магнитной анизотропии,  $\gamma$  – константа магнитоэластики.

До сих пор все выше перечисленные примеры реализации в слоистых магнитных гетероструктурах эффекта коллапса акустического резонанса Фано и сопутствующих динамических явлений были рассмотрены только для: 1) условий упругой и магнитной изотропии в плоскости падения, 2) возможности формирования в ферро- и антиферромагнитном слое поверхностной безобменной магнитодипольной спиновой волны. Однако, анализ показывает, что для слоистой магнитной гетероструктуры формирование акустических аналогов резонанса Фано и его коллапса, ССК и сверхизлучения вследствие влияния эласто-дипольного механизма возможно также и для других магнитоакустических конфигураций. Как пример, рассмотрим слой легкоосного ( $OZ$ ) АФМ, свободная энергия которого с учетом (22) и неоднородного обменного взаимодействия может быть представлена как

$$F = F_{AF} + \frac{\alpha}{2} M_0^2 (\nabla \mathbf{l})^2, \quad (23)$$

где  $\alpha$  – константа неоднородного обмена [23]. Будем теперь полагать, что  $\mathbf{k} \in YZ$ ,  $\mathbf{l}_0 \parallel \mathbf{q} \parallel OZ$ ,  $\mathbf{u} \parallel OX$ , а система граничных условий на обеих поверхностях АФМ слоя имеет вид

$$\sigma_{zx} = \tilde{\sigma}_{zx}, \quad u_x = \tilde{u}_x, \quad \frac{\partial l_x}{\partial z} = 0, \quad B_z = 0, \quad z = \pm d \quad (24)$$

(т.е. рассматриваемый АФМ слой по-прежнему имеет двухстороннее ультратонкое покрытие бесконечным слоем идеального сверхпроводника (при  $\tilde{\mu}_{\perp} = 0$ ), но при этом спины на обеих поверхностях АФМ слоя полностью свободны). При этом в неограниченном АФМ (22)–(23) спектр сдвиговой упругой волны с  $\mathbf{k} \in YZ$  в этом случае можно представить как ( $k^2 = k_y^2 + k_z^2$ ):

$$\omega^2 \frac{k^2}{k^2 + \kappa k_y^2} = \omega_0^2 + \omega_{me}^2 \frac{k_y^2 - \omega^2/s_t^2}{k^2 - \omega^2/s_t^2} + c^2 k^2. \quad (25)$$

Здесь  $\kappa \equiv 16\pi/\delta$ ,  $\omega_0$  – частота однородного АФМ резонанса.  $\omega_{me}$  – магнитоупругая щель,  $\omega_s \equiv gM_0$ ,  $g$  – магнитомеханическое отношение [17, 23]. Для  $\mathbf{u} \parallel \mathbf{a}$  решение граничной задачи (24)–(25) можно искать в виде:

$$u_x = \sum_{i=1}^3 (A_i c_i + B_i s_i) \exp(i\psi_y), \quad \psi_y \equiv hy - \omega t, \quad (26)$$

где  $A_{1-3}$ ,  $B_{1-3}$  – константы, подлежащие определению  $c_i \equiv \text{ch}(\eta_i z)$ ,  $s_i \equiv \text{sh}(\eta_i z)$ ,  $\eta_{1-3}$  – корни характеристического кубического относительно  $k_z^2$  уравнения (25) при условии, что  $\eta^2 \equiv -k_z^2$ . Расчет показывает, что при выполнении граничных условий

(24) для слоя обсуждаемой АФМ среды (3), (17), (22), (23), (25) в симметричном немагнитном окружении (1) спектр распространяющихся в сагиттальной плоскости  $YZ$  вытекающих (или собственных) сдвиговых эласто-дипольных волн с  $\mathbf{u} \parallel OX$  факторизуется и при одновременном учете МУ, магнито-дипольного и неоднородного обменного взаимодействий. В этом случае структура матрицы перехода по-прежнему может быть представлена как (9)–(11). Одновременно сохраняется также и структура соотношений (13)–(16), (18)–(20). Это означает, что и для рассматриваемой магнитоакустической конфигурации все выше отмеченные для сдвиговой волны  $SH$ -типа эффекты, относящиеся как к формированию и коллапсу резонанса Фано, так и к эффекту акустического сверхизлучения при выполнении (21) остаются в силе. Дополнительные механизмы формирования ССК (как и точек коллапса резонанса Фано) в спектре сдвиговой трехпарциальной МУ волны (25)–(26), распространяющейся вдоль слоя рассматриваемой АФМ среды (22)–(23), возникают для тех сочетаний  $\omega$ ,  $h$ , при которых в (26) как минимум два корня характеристического кубического относительно  $k_z^2 > 0$  уравнения (25) являются действительными. Однако теперь для сдвиговых объемных волн  $SH$ -типа, распространяющихся вдоль АФМ слоя (22)–(25) на плоскости внешних параметров  $\omega - h$ , соотношение (20) для точек коллапса резонанса Фано (а также частот ССК), индуцированных МУ взаимодействием объемных сдвиговых упругих и дипольно-обменных спиновых волн (симметричных или антисимметричных), имеет вид ( $p_\nu^2 \equiv (\pi\nu/2d)^2 + h^2$ ,  $\bar{\omega}_0^2 \equiv \omega_0^2 + \omega_{me}^2$ ):

$$D_\nu(\omega, h) = D_\rho(\omega, h), \quad \nu \neq \rho, \quad \nu, \rho = 1, 2, \dots \quad (27)$$

$$D_\nu(\omega, h) = \omega^2 \frac{p_\nu^2}{p_\nu^2 + \kappa h^2} - \bar{\omega}_0^2 - c^2 p_\nu^2 + \omega_{me}^2 \frac{p_\nu^2 - h^2}{p_\nu^2 - \omega^2/s_t^2}. \quad (28)$$

Как показывает расчет, условия (27), (28) определяют с учетом гибридизации магнито-дипольного, МУ и неоднородного обменного взаимодействия точки вырождения спектра сдвиговых объемных МУ волн, распространяющихся вдоль АФМ слоя, на обеих поверхностях которого выполнены граничные условия (24) с  $\tilde{u}_x = 0$ . Следует отметить, что уже в безобменном пределе ( $c^2 \rightarrow 0$ ) условия (27), (28) определяют с учетом магнито-дипольного и МУ взаимодействия точки вырождения спектра сдвиговых объемных МУ волн распространяющихся вдоль АФМ слоя,

на обеих поверхностях которого выполнены граничные условия (25), если  $\tilde{u}_x = 0$  (жесткое закрепление [11]). При снятии такого вырождения спектров объемных упругих и магнито-статических спиновых волн для сочетаний частоты и продольного волнового числа в окрестности (27)–(28) вдоль рассматриваемого АФМ слоя распространяются быстрые МУ волны [24].

Из анализа (27)–(28) следует, что для рассматриваемой магнитоакустической конфигурации включение в рассмотрение в (22)–(23) неоднородного обмена ( $\alpha \neq 0$ ) делает возможным реализацию ряда новых механизмов формирования на плоскости параметров “ $\omega - h$ ” точек, отвечающих ССК (20). В частности, для  $\omega^2/s_t^2 > p_\nu^2$ ,  $\omega^2 f_\nu(\kappa, h) > \bar{\omega}_0^2 + c^2 p_\nu^2$  уже при переходе к формальному пределу  $\kappa \rightarrow 0$  (пренебрежение магнитодипольным взаимодействием) в спектре распространяющихся вдоль АФМ слоя (22)–(28) объемных МУ волн  $SH$ -типа имеются дополнительные точки формирования эффекта коллапса резонанса Фано (а также ССК). Они являются результатом вырождения спектров объемных обменных спиновых и объемных сдвиговых упругих волн распространяющихся вдоль АФМ слоя. При снятии вырождения в окрестности этих дополнительных точек ССК для объемных МУ волн, распространяющихся вдоль рассматриваемого АФМ слоя, реализуются условия антирезонанса (магнитоакустического резонанса [25]).

Ряд дополнительных механизмов формирования ССК (точек коллапса резонанса Фано) на плоскости внешних параметров  $\omega - h$  имеет место даже если  $\omega^2 \ll s_t^2/(2d)^2$ . В частности, как показывает расчет, уже при формальном предельном переходе  $\gamma \rightarrow 0$ ,  $4\pi c \neq 0$ , возможен дипольно-обменный механизм. Его можно рассматривать как вырождение спектров магнито-статических и обменных объемных спиновых волн. При снятии указанного вырождения для сочетаний частоты и продольного волнового числа в окрестности (27)–(28) вдоль рассматриваемого АФМ слоя формируются распространяющиеся дипольно-обменные спиновые волны (дипольно-обменный неоднородный спин-спиновый резонанс [17]).

Если же рассматриваемый АФМ (22)–(23) является низкотемпературным (т.е. для него  $c < s_t$  [23]), то на плоскости внешних параметров  $\omega - h$  (уже при  $\omega^2 \ll s_t^2/(2d)^2$ ) становится возможным также и формирование в спектре МУ волн точек ССК другого типа. В частности, их реализация возможна, даже если в (27), (28) выполнить формальный предельный переход  $\kappa \rightarrow 0$ ,  $\gamma c \neq 0$ . Физически их появление являет-

ся следствием вырождения спектров распространяющихся вдоль АФМ слоя эластостатических и обменных объемных спиновых волн. При снятии указанного вырождения для соответствующих сочетаний частоты и продольного волнового числа в окрестности (27), (28) вдоль рассматриваемого АФМ слоя распространяются эласто-обменные спиновые волны (эласто-обменный неоднородный спин-спиновый резонанс [26]).

Следует отметить, что для всех рассмотренных выше магнитоакустических конфигураций для падающей из (1) плоской объемной сдвиговой волны  $W_{SH}(h) = W_{SH}(-h)$ ,  $V_{SH}(h) = V_{SH}(-h)$ . Вместе с тем расчет показывает, что эти соотношения могут нарушаться. В частности, если у распространяющейся сдвиговой акустической волны вектор упругих смещений  $\mathbf{u} \parallel OZ$ , а волновой вектор  $\mathbf{k} \in XY$ , то это возможно уже для акустически сплошной сэндвич-структуры, состоящей из слоя ( $-d < y < d$ ) среды (2)–(10), обе поверхности которого имеют сплошной акустически контакт через упруго изотропные слои сред  $A$  (толщина слоя  $d_A$ ) и  $B$  (толщина слоя  $d_B$ ) с неограниченной средой (1). Например, если магнитный слой имеет акустически бесконечно тонкое сверхпроводящее покрытие, то вместо граничных условий (4) получаем

$$\begin{aligned} \sigma_{zy}^A &= \tilde{\sigma}_{zy}, \quad u_z^A = \tilde{u}_z, \quad y = d + d_A, \\ \sigma_{zy}^A &= \sigma_{zy}, \quad u_z^A = u_z, \quad B_y = 0, \quad y = d, \\ \sigma_{zy}^B &= \sigma_{zy}, \quad u_z^B = u_z, \quad B_y = 0, \quad y = -d, \\ \sigma_{zy}^B &= \tilde{\sigma}_{zy}, \quad u_z^B = \tilde{u}_z, \quad y = -d - d_B, \end{aligned} \quad (29)$$

где  $\sigma_{zy}^A$  ( $\sigma_{zy}^B$ ) и  $u_z^A$  ( $u_z^B$ ) – соответственно компоненты тензора упругих деформаций  $\sigma_{ik}$  и вектора упругих смещений  $\mathbf{u}$  в упруго изотропной среде  $A(B)$ .

В результате  $W_{SH}(h) \neq W_{SH}(-h)$ ,  $V_{SH}(h) \neq V_{SH}(-h)$ , возможно уже тогда, когда среды  $A$  и  $B$  идентичны по своим упругим параметрам, но  $d_A \neq d_B$ , или когда  $d_A = d_B$ , но параметры сред  $A$  и  $B$  не эквивалентны между собой. Это означает, что в подобной магнитоакустической конфигурации (геометрия Фогта) будут не взаимны относительно  $h \rightarrow -h$  и найденные выше для (2)–(10) условия формирования и коллапса резонанса Фано, связанных состояний в континууме сдвиговых упругих волн, темных и светлых мод, а если в (29) вместо магнитного слоя –  $N$ -слойная магнитная гетероструктура (14), то не взаимным будет также и эффект сверхизлучения. Отметим, что если падающая из среды (1)  $SH$ -волна не является плоской, то в условиях

(2)–(10), (29) и рассматриваемой магнитоакустической конфигурации эффект не взаимности при инверсии  $h \rightarrow -h$  характерен так же, как для пространственного  $(\Delta_V, \Delta_W)$ , так и для углового  $(s_V, s_W)$  эффектов Шоха, возникающих для обсуждаемой магнитной гетероструктуры (29) не только при наклонном, но и при нормальном падении как для отраженной  $(\Delta_V, s_V)$ , так и для прошедшей  $(\Delta_W, s_W)$  объемной сдвиговой волны. Это связано с тем, что если случае (2)–(10), (29) из среды (1) на внешнюю поверхность рассматриваемого асимметричной сэндвич-структуры падает квазиплоская объемная  $SH$ -волна, то  $-i\Delta_V + s_V = \partial \ln V_{SH} / \partial h$ ,  $-i\Delta_W + s_W = \partial \ln W_{SH} / \partial h$ .

Таким образом влияние эласто-дипольного взаимодействия на прохождение сдвиговых упругих фононов через магнитные сэндвич-структуры типа диэлектрик–сверхпроводник сформированных с участием ФМ или АФМ слоев, делает возможным реализацию магнитоакустических аналогов, хорошо известных в физике полупроводниковых гетероструктур поляритонных эффектов [3, 21], включая формирование и коллапс резонанса Фано, связанные состояния в континууме поперечных фононов, темные и светлые моды, сверхизлучение. Для асимметричных слоистых магнитных гетероструктур указанные эффекты могут быть не взаимными относительно инверсии знака продольного волнового числа (угла наклона для падающей извне плоской  $SH$ -волны). Отметим также, что в окрестности указанных точек ССК (20), (27), (28) в рамках рассматриваемой бездиссипативной модели ширина линии связанной с радиационным затуханием вытекающей сдвиговой МУ волны в соответствии с теорией [27] может быть сколь угодно малой (т.е. подобно [4], такие магнитоакустические моды можно охарактеризовать как суперрезонансное состояние).

Работа выполнена в рамках государственного задания.

1. F. Zangeneh-Nejad and R. Fleury, Rev. Phys. **4**, 100031 (2019).
2. D. Zhao, Y.-T. Wang, K.-H. Fung, Z.-Q. Zhang, and C. T. Chan, Phys. Rev. B **101**, 054107 (2020).
3. A. V. Kavokin, J. J. Baumberg, G. Malpuech, and F. P. Laussy, *Microcavities*, 2-nd ed., Oxford University Press, N.Y. (2017).
4. М. В. Рыбин, М. Ф. Лимонов, УФН **189**, 881 (2019).
5. K. Yu, N. X. Fang, G. Huang, and Q. Wang, Adv. Mater. **30**, 1706348 (2018).
6. А. А. Бухараев, А. К. Звездин, А. П. Пятаков, Ю. К. Фетисов, УФН **188**, 1288 (2018).

7. O. S. Latcham, Y. I. Gusieva, A. V. Shytov, O. Y. Gorobets, and V. V. Kruglyak, *APL* **115**, 082403 (2019).
8. O. S. Latcham, Y. I. Gusieva, A. V. Shytov, O. Y. Gorobets, and V. V. Kruglyak, arXiv preprint arXiv:1911.06774 (2019).
9. O. S. Latcham, Y. I. Gusieva, A. V. Shytov, O. Y. Gorobets, and V. V. Kruglyak, *APL* **116**, 209902 (2020).
10. O. S. Latcham, Y. I. Gusieva, A. V. Shytov, O. Y. Gorobets, and V. V. Kruglyak, arXiv:1906.07297v2 [physics.app-ph] (2020).
11. М. А. Исакович, *Общая акустика*, Наука, М. (1973).
12. J. P. Parekh, *Electron. Lett.* **6**, 322 (1969).
13. О. В. Приходько, О. С. Сухорукова, С. В. Тарасенко, В. Г. Шавров, *Письма в ЖЭТФ* **95**, 733 (2012).
14. И. Е. Дзялошинский, *ЖЭТФ* **33**, 807 (1957).
15. Т. В. Лаптева, С. В. Тарасенко, В. Г. Шавров, *Письма в ЖЭТФ* **85**, 751 (2007).
16. М. В. Балакирев, И. А. Гилинский, *Волны в пьезокристаллах*, Наука, Новосибирск (1982).
17. А. Г. Гуревич, Г. А. Мелков, *Магнитные колебания и волны*, Физматлит, М. (1994).
18. Л. М. Бреховских, *Волны в слоистых средах*, изд-во АН СССР, М. (1957).
19. В. И. Альшиц, А. Л. Шувалов, *ЖЭТФ* **103**, 1356 (1993).
20. C. W. Hsu, B. Zhen, A. D. Stone, J. D. Joannopoulos, and M. Soljačić, *Nat. Rev. Mater.* **1**, 16048 (2016).
21. Е. Л. Ивченко, А. Н. Поддубный, *ФТТ* **55**, 833 (2013).
22. Ч. С. Ким, А. М. Сатанин, Ю. С. Джое, Р. М. Косби, *ЖЭТФ* **116**, 263 (1999).
23. В. И. Ожогин, В. Л. Преображенский, *УФН* **155**, 593 (1988).
24. Ю. В. Гуляев, П. Е. Зильберман, *Изв. вузов. Физика* **31**, 6 (1988).
25. А. И. Ахиезер, В. Г. Барьяхтар, С. В. Пелетминский, *Спиновые волны*, Наука, М. (1967).
26. Ю. В. Гуляев, С. В. Тарасенко, В. Г. Шавров, *УФН* **181**, 595 (2011).
27. H. Friedrich and D. Wintgen, *Phys. Rev. A* **32**, 3231 (1985).